

● **XXVIII Международный симпозиум „Нанофизика и нанoeлектроника“, Нижний Новгород, 11–15 марта 2024 г.**

Перов А.А., Пикунов П.В.

Фотогальванический эффект в электронном газе планарных сверхрешеток без центра инверсии в постоянном однородном магнитном поле 343

Мансуров В.Г., Малин Т.В., Башкатов Д.Д., Милахин Д.С., Журавлев К.С.

Химическая кинетика процесса нитридации поверхности Si(111) при температурах ниже структурного фазового перехода $(7 \times 7) \rightarrow (1 \times 1)$ 349

Василькова Е.И., Баранцев О.В., Баранов А.И., Пирогов Е.В., Воропаев К.О., Васильев А.А., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Соболев М.С.

Исследование температурной зависимости темновых токов *p/n*-фотодиодов на основе эпитаксиальных гетероструктур $\text{In}_{0.83}\text{Ga}_{0.17}\text{As}/\text{InP}$ с метаморфными буферными слоями . . . 358

Беляев Д.В., Коваленко Ю.Е., Титов А.А., Голяшов В.А., Терещенко О.Е., Чумаков Р.Г., Титов А.Н., Кузнецова Т.В.

Электронная структура янусовских слоев на основе $\text{Tl}_{1-x}\text{Cr}_x(\text{Se}_{1-x}\text{S}_x)_2$ 365

Пономарев С.А., Курусь Н.Н., Голяшов В.А., Мионов А.Ю., Роголо Д.И., Милехин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В.

Фазовый переход $\beta \Leftrightarrow \beta'$ с температурным гистерезисом в пленках In_2Se_3 370

Кузнецов Ю.М., Дорохин М.В., Калентьева И.Л., Здравейщев А.В., Демина П.Б., Ерофеева И.В., Трушин В.Н., Болдин М.С., Ланцев Е.А.

Синтез и термоэлектрические свойства высшего силицида марганца 376

● **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Маслов А.Ю., Прошина О.В.

Поляронная масса носителей в квантовых ямах из ионного материала 381

● **Физика полупроводниковых приборов**

Акимов А.И., Кириенко В.В., Блошкин А.А., Двуреченский А.В., Уткин Д.Е.

Усиление фототока в кремниевых фотодиодах с квантовыми точками Ge гибридными плазмонными и диэлектрическими модами планарного волновода 386